

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 3 区分  
 【発行日】平成 28 年 4 月 7 日 (2016.4.7)

【公開番号】特開 2013-229013 (P2013-229013A)  
 【公開日】平成 25 年 11 月 7 日 (2013.11.7)  
 【年通号数】公開・登録公報 2013-061  
 【出願番号】特願 2013-49821 (P2013-49821)  
 【国際特許分類】

G 0 6 F 3/06 (2006.01)

【 F I 】

G 0 6 F 3/06 3 0 2 A

G 0 6 F 3/06 5 4 0

【手続補正書】

【提出日】平成 28 年 2 月 17 日 (2016.2.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

外部から入力されたデータを複数の記憶デバイスのいずれかに記憶させる機能を有するアレイコントローラであって、

前記複数の記憶デバイスのうち、いずれかに前記データを記憶させるかを指定する機能を有するプロセッサと、

前記データを記憶し、前記データを前記複数の記憶デバイスのいずれかに出力する機能を有するキャッシュメモリと、を有し、

前記キャッシュメモリは、チャンネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタを有することを特徴とするアレイコントローラ。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記トランジスタのチャンネル幅 1  $\mu$ m あたりのオフ電流は、温度が 25 において 100  $\mu$ A /  $\mu$ m 以下であることを特徴とするアレイコントローラ。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 において、

前記記憶デバイスは、ハードディスクであることを特徴とするアレイコントローラ。

【請求項 4】

複数の記憶デバイスと、

外部から入力されたデータを前記複数の記憶デバイスのいずれかに記憶させる機能を有するアレイコントローラと、を有し、

前記アレイコントローラは、前記複数の記憶デバイスのうち、いずれかに前記データを記憶させるかを指定する機能を有するプロセッサと、前記データを記憶し、前記データを前記複数の記憶デバイスのいずれかに出力する機能を有するキャッシュメモリと、を有し、

前記キャッシュメモリは、チャンネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタを有することを特徴とするストレージシステム。

【請求項 5】

複数の記憶デバイスと、

外部から入力されたデータを前記複数の記憶デバイスのいずれかに記憶させる機能を有するアレイコントローラと、

前記データを記憶し、前記データを前記複数の記憶デバイスのいずれかに出力する機能を有するキャッシュメモリと、を有し、

前記アレイコントローラは、前記複数の記憶デバイスのうち、いずれかに前記データを記憶させるかを指定する機能を有するプロセッサを有し、

前記キャッシュメモリは、チャンネル形成領域に酸化物半導体を含むトランジスタを有することを特徴とするストレージシステム。

**【請求項 6】**

請求項 4 または請求項 5 において、

前記トランジスタのチャンネル幅  $1\ \mu\text{m}$  あたりのオフ電流は、温度が  $25$  において  $100\ \text{zA}/\mu\text{m}$  以下であることを特徴とするストレージシステム。

**【請求項 7】**

請求項 4 乃至 6 のいずれかーにおいて、

前記記憶デバイスは、ハードディスクであることを特徴とするストレージシステム。